

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-163528

(43)Date of publication of application : 09.06.1992

(51)Int.Cl. G02F 1/136
G02F 1/1333

(21)Application number : 02-292719

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing : 29.10.1990

(72)Inventor : NISHIMURA KENICHI
TANAKA HIROHISA
HISHIDA TADANORI

(54) ACTIVE MATRIX DISPLAY

(57)Abstract:

PURPOSE: To keep off any possible separation at the time of patterning for a transparent electrode by forming a transparent insulating film into a multilayer film where an organic insulating film and an inorganic insulating film are laminated in order.

CONSTITUTION: A layer insulating film is formed into a two-layer structure consisting of an organic insulating film 10 and an inorganic insulating film 110 interposing between this organic insulating film 10 and a picture element electrode 11. This inorganic insulating film 110 is formed so as to cover the whole upper part of the organic insulating film 10, and there is provided a contact hole for connecting the picture element electrode 11 to a drain electrode 8 as well. In this case, this contact hole is made smaller than another contact hole formed in the insulating film 10. With this constitution, any possible separation at the time of patterning for the picture element electrode is thus preventable.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-163528

⑬ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成4年(1992)6月9日

G 02 F

1/136
1/13335 0 0
5 0 59018-2K
8808-2K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

⑮ 発明の名称 アクティブマトリクス表示装置

⑯ 特 願 平2-292719

⑰ 出 願 平2(1990)10月29日

⑱ 発 明 者 西 村 健 一 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社
内

⑲ 発 明 者 田 仲 広 久 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社
内

⑳ 発 明 者 栗 田 忠 則 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社
内

㉑ 出 願 人 シヤープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

㉒ 代 理 人 弁理士 梅 田 勝 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

アクティブマトリクス表示装置

2. 特許請求の範囲

1. 絶縁性透明基板、該基板上に設けられた薄膜トランジスタアレイ、該薄膜トランジスタアレイを覆うように形成された透明絶縁膜及び該透明絶縁膜に形成されたコンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタアレイの各薄膜トランジスタのドレイン電極と電気的に接続している給電電極を有するアクティブマトリクス表示装置であって、前記透明絶縁膜が有機系絶縁膜、無機系絶縁膜の順に積層された多層膜であることを特徴とするアクティブマトリクス表示装置。
2. 前記有機系絶縁膜がポリイミド樹脂膜またはアクリル樹脂膜であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のアクティブマトリクス表示装置。
3. 前記無機系絶縁膜が酸化シリコン膜または窒化シリコン膜であることを特徴とする特許請求

の範囲第1項記載のアクティブマトリクス表示装置。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、アクティブマトリクス表示装置の構造に関するものであり、特に高解像度液晶表示装置に用いる薄膜トランジスタ(以下TFTと略称する。)アクティブマトリクス表示装置の構造に関するものである。

<従来の技術>

アクティブマトリクス表示装置、特に液晶を用いるアクティブマトリクス表示装置は表示コントラストが高く、表示容量に制約が少ない等の利点があるため研究開発が盛んに行われており、実用化が進みつつある。ところがアクティブマトリクス表示装置に用いるアクティブマトリクス基板は製造工程が複雑で歩留まりが低いため、コストが高いという欠点がある。

典型的なアクティブマトリクス基板について、その主要な部分の平面図を第8図に、その部分の

特開平4-163528(2)

断面図を第4図に示す。このアクティブマトリクス基板は、透明絶縁性基板1と、この透明絶縁性基板1上にマトリクス状に配列された給素電極11と、ゲートバス配線3と、ソースバス配線7と、これら給素電極11、ゲートバス配線3及びソースバス配線7に接続されているスイッチング素子であるTFTを有する。

前記透明絶縁性基板1上に形成されたTFT近傍の断面構造は、第4図に示す通りである。透明絶縁性基板1上にゲート電極2が形成され、ゲート電極2は基板1上の全面に形成されているゲート絶縁膜4によって覆われている。ゲート電極2の上方のゲート絶縁膜4上には、アモルファスシリコン（以下では α -Siと略称する）からなる半導体層5が形成されている。半導体層5上には同局部において n^+ 型 α -Siからなるコンタクト層（図示していない。）が形成され、コンタクト層上にはそれぞれソース電極6とドレイン電極8が形成されている。ソース電極6はドレイン電極8とは反対側の部分においてソースバス配線7

に接続している。このソースバス配線7はソース電極8の上記部分と同様にゲート絶縁膜4上に形成されている。そして、前記給素電極11は大部分が絶縁膜4上に形成される一方で一部分が前記ドレイン電極8上に重畳して形成されている。なお、前記ゲート電極2はゲートバス配線（図示せず）に接続されている。

このようにして形成されているTFT上には保護膜（図示せず）が形成され、更にこのようにして形成された透明絶縁性基板1上の全面には配向膜（図示せず）が形成され、この基板を配向膜、透明電極等が形成されている透明絶縁性基板（図示せず）との間に液晶層を封入することによりアクティブマトリクス液晶表示装置が形成される。

ところが、前記のように形成されたアクティブマトリクス基板には不良の発生することがある。この不良の原因の一つにソースバス配線7と給素電極11との間のショートがある。これは、ソースバス配線7と給素電極11とは同じゲート絶縁膜4上に形成されているばかりでなく、相互の間

隔が高橋程にすればする程接近することが要因と考えられる。

そこで、このソースバス配線7と給素電極11との間のショートを防止するためには、当該配線7と給素電極11とを異なる層上に形成する構造が提案される。

第5図は、ソースバス配線と給素電極を別の層に形成したアクティブマトリクス基板の断面図を示す。第5図において第4図と同等部分は同一符号で示す。層間絶縁膜10は、TFTが形成されている透明絶縁性基板1のほぼ全面に形成されている。この層間絶縁膜10はTFTのドレイン電極8の端部の中央部上面において欠如しているホールが形成されており、このホールが層間絶縁膜10上に形成されている給素電極11をドレイン電極8に電気的に接続するためのコンタクトホール12として等価している。即ち、給素電極11は層間絶縁膜10上から上記ドレイン電極8の端部上を覆うよう形成されている。

このような構造のアクティブマトリクス基板は、

ソースバス配線7と給素電極11はそれらの間に層間絶縁膜10が存在する立体的構造をなしていることから、平面に投影した場合の間隔をなくすることが可能となる。この構造のアクティブマトリクス基板の平面図を第6図に示しており、この図から明らかなようにソースバス配線7と給素電極11が重なっている。なお、重なっている部分は第6図に斜線で示す。又、ゲートバス配線3と給素電極11が重なっている部分も斜線で示す。従って給素電極11の面積を大きくすることができる。給素電極11の面積が大きいと、表示装置に用いた場合の開口率が大きくなり表示品位が高まるといふ利点もある。更に、この層間絶縁膜10をポリイミド樹脂などの樹脂を塗布することにより形成すると、アクティブマトリクス基板表面の段差を平坦化することができ、液晶表示装置に用いた場合に問題となる段差による液晶の配向不良を低減することもできる。

このようなアクティブマトリクス基板は、以下のようにして製造される。まず、ガラス等の透明

特開平4-163528(8)

絶縁性の基板1の上にT_a-C_t等から成るゲート電極2を形成する。次に、SiNx、SiO_x等から成るゲート絶縁膜4、非晶質シリコン(以下a-Siと略す。)、多結晶シリコン、CdSe等から成る半導体層5を覆層する。更に、Ti、Mo、Al等から成るソース電極6及びドレイン電極8を形成する。通常、オーミックコンタクトを取るために半導体層5とソース電極6及びドレイン電極8の間にリンをドーパしたa-Si(以下p-Siと略称する。)層9が設けられる。最後に、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂等から成る有機系絶縁膜10、ITO等の透明導電膜から成る給電電極11を形成する。

<本発明が解決しようとする課題>

前記層間絶縁膜となる有機系絶縁膜上に直接給電電極となる透明電極膜例えば金属酸化物例えばITO(Indiumtin oxide)の膜をパターンニングすると、有機系絶縁膜とITOの膜の密着性が悪いため、ITOのはがれがみえる。このようなはがれが発生するとアクティブマトリクス基

板の歩留りを低下させ、コスト高を招き、このアクティブマトリクス基板を用いている表示装置の歩留りを低下させる原因となる。

そこで、本発明はアクティブマトリクス表示装置に用いるアクティブマトリクス基板にあって、給電電極である透明電極のパターンニング時のはがれが防止しうるアクティブマトリクス基板の提供を目的とする。

<課題を解決するための手段>

本発明のアクティブマトリクス表示装置によれば、絶縁性透明基板、該基板上に設けられた薄膜トランジスタアレイ、該薄膜トランジスタアレイを覆うように形成された透明絶縁膜及び該透明絶縁膜に形成されたコンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタアレイの各薄膜トランジスタのドレイン電極と電気的に接続している給電電極を有するアクティブマトリクス表示装置にあって、前記透明絶縁膜が有機系絶縁膜、無機系絶縁膜の順に積層された多層膜とすることによって上記目的が達成される。なお、ここで前記有機系絶縁膜

に形成されたコンタクトホールより前記無機系絶縁膜に形成されたコンタクトホールの方を小さくすることができる。そして、前記有機系絶縁膜をポリイミド樹脂膜またはアクリル樹脂膜とし、又前記無機系絶縁膜を酸化シリコン膜または窒化シリコン膜とすることにより、上記目的が良好に達成される。

<作 用>

本発明によれば、有機系絶縁膜と給電電極膜である透明電極膜との間に無機系絶縁膜が介在しており、給電電極膜は無機系絶縁膜上に配置されるために密着性が高まり、はがれが防止できる。ここで、無機系絶縁膜を酸化シリコン膜または窒化シリコン膜とすることにより給電電極膜との密着性が良好であり望ましい。又、有機系絶縁膜をポリイミド樹脂またはアクリル樹脂により形成することが望ましい。

<実施例>

本発明のアクティブマトリクス表示装置に用いるアクティブマトリクス基板の一実施例の断面図

を第1図に示す。第1図において、第5図と同等部分は同一符号にて示している。第1図において層間絶縁膜が有機系絶縁膜10と、その有機系絶縁膜10と給電電極11との間に介在する無機系絶縁膜110との2層構造となっている。

この有機系絶縁膜10はポリイミド樹脂、アクリル樹脂等の有機系材料であるが、実施例ではポリイミド樹脂の例を挙げる。そして、前記無機系絶縁膜110は酸化シリコン膜、窒化シリコン膜等の無機系材料であるが、実施例では酸化シリコンの例を挙げる。又、有機系絶縁膜10の膜厚は5000~20000Å程度とすることができ、無機系絶縁膜110の膜厚は500~6000Å程度とすることができ、給電電極11の膜厚は500~2000Åとすることができ、この無機系絶縁膜110は、有機系絶縁膜10の上方全面を覆うように形成されており、給電電極11がドレイン電極8と接続するためのコンタクトホールが形成されており、当該コンタクトホールは絶縁膜10に形成されているコンタクトホールよ

特開平4-163528(4)

り小さくされている。なお、無機系絶縁膜110は、この実施例では有機系絶縁膜10の全面を覆うように形成されている例を説明したが、絶縁電極11のはがれ防止の目的からは絶縁電極11に対応する部分乃至それより一まわり大きく形成することもできる。

第1図に示す、本発明の一実施例であるアクティブマトリクス基板の製造方法を第2図(a), (b), (c)に従って説明する。まず、ガラス基板1上に、スパッタリング法により3000ÅのTa膜を形成して、フォトリソグラフィによりパターンニングしてゲート電極2とする。次に、プラズマCVD法により4000ÅのSiNxから成るゲート絶縁膜4、1600Åのa-Siから成る半導体層5及び400Åのn⁺-Si層9を連続して形成して、パターンニングする。更に、スパッタリング法により2000ÅのMoを形成して、ソース電極6及びドレイン電極8の形状にパターンニングすることによりTFTアレイをマトリクス状に形成する(第2図(a))。このときソース電極6と接続

するソースバス配線7も形成される。ポリイミド樹脂を1μm塗布し、パターンニングし、有機系絶縁膜10を形成する。次に、スパッタリング法により、1000ÅのSiO₂膜を形成し、コンタクトホールを露出させる。ポリイミド樹脂パターンニングしたときのマスクよりも小さいマスクを用いてパターンニングし、無機系絶縁膜110を形成する。

(第2図(b))最後に、スパッタリング法により、1000ÅのITO膜を形成し、絶縁電極11の形状にパターンニングし、絶縁電極11を形成する(第2図(c))。

前記実施例のアクティブマトリクス基板においては、層間絶縁層が有機系絶縁膜10であるポリイミド樹脂膜10の上に形成された、無機系絶縁膜110であるSiO₂膜110の上に、更に絶縁電極11であるITO11が形成されているため、ITOはSiO₂膜との密着性が良くはがれが防止される。そして、このアクティブマトリクス基板を液晶表示素子に用いる場合には、該アクティブマトリクス基板上に液晶の配向膜として更

にポリイミド樹脂が塗布されることとなるが、ポリイミド樹脂膜10の上面が酸化シリコン膜110で覆われるのでポリイミド樹脂膜10に影響を及ぼすことがない。即ち、第3図に示すアクティブマトリクス基板のように絶縁電極11が層間絶縁膜10を部分的に覆っている場合、液晶の配向膜として更にポリイミド樹脂を直接塗布すると、該ポリイミド樹脂が層間絶縁膜10であるポリイミド樹脂に接触するため、層間絶縁膜10用のポリイミド樹脂が膨潤し、クラックや膜剥がれが発生しやすいという問題があるが、本発明ではポリイミド樹脂膜10の表面が酸化シリコン樹脂膜110で覆われており、このような問題が生じなくなる。

<発明の効果>

本発明のアクティブマトリクス表示装置に用いるアクティブマトリクス基板によれば、絶縁電極がパターンニング時の剥がれが防止できる。この結果、アクティブマトリクス基板の歩留まりが向上し、アクティブマトリクス表示装置の実用性を高

めることができる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のアクティブマトリクス表示装置に用いるアクティブマトリクス基板の1実施例を示す断面図を示し、

第2図(a), (b), (c)は本発明の前述1実施例の製造工程を示す断面図を示し、

第3図は従来構造のアクティブマトリクス基板の要部平面図を示し、

第4図は従来構造のアクティブマトリクス基板の断面図を示し、

第5図は従来構造を改良したアクティブマトリクス基板の断面図を示し、

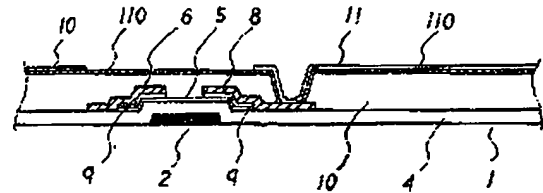
第6図は改良されたアクティブマトリクス基板の要部平面図を示す。

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1:透明絶縁性基板 | 2:ゲート電極 |
| 3:ゲートバスライン | 4:ゲート絶縁膜 |
| 5:a-Si膜 | 6:ソース電極 |
| 7:ソースバスライン | 8:ドレイン電極 |
| 9:n ⁺ -Si膜 | 10:有機系層間絶縁膜
(有機系絶縁膜) |

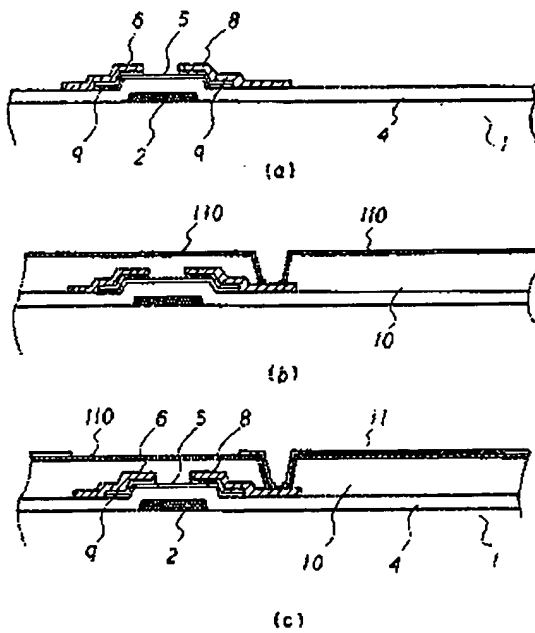
特開平 4-163528(5)

11:絶縁電極 12:コンタクトホール
110:無機系絶縁膜

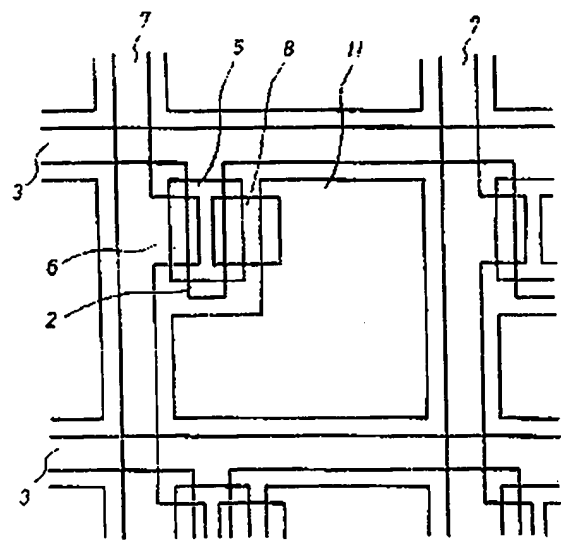
代理人 弁護士 梅田 勝(他2名)



第1図

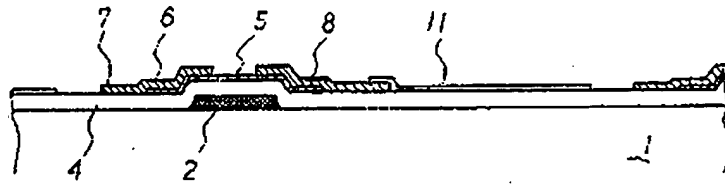


第2図

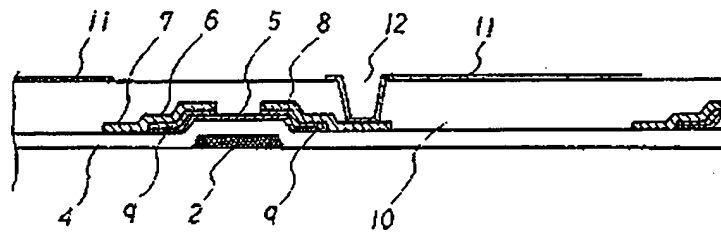


第3図

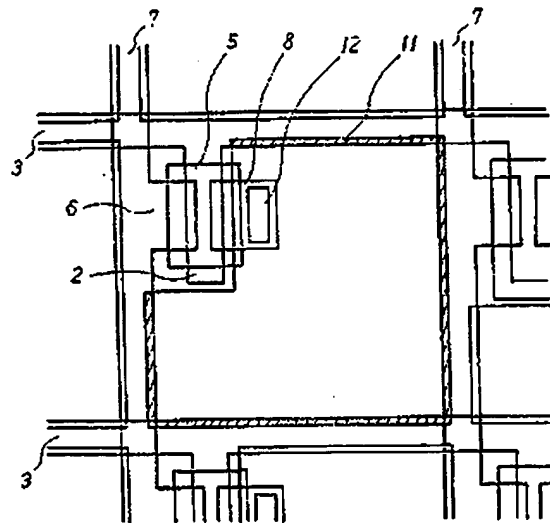
特開平 4-163528(6)



第 4 図



第 5 図



第 6 図

特開平4-163528

8. 符号の説明

1. 基板が基板、該基板上に設けられた複数のトランジスタアレイ、該複数のトランジスタアレイを覆うように形成された絶縁膜及び該絶縁膜に形成されたコンタクトホールを介して前記複数のトランジスタアレイの各電極とラングスタのドレイン電極と電気的に接続している状態を有するアクティブマトリクス表示装置において、

前記絶縁膜が有機系絶縁膜と無機系絶縁膜を覆って形成された多層構造の膜上の層構造であることを特徴とするアクティブマトリクス表示装置。

2. 前記有機系絶縁膜がポリイミドに形成されたアクティブマトリクス表示装置。

3. 前記有機系絶縁膜がポリイミドに形成されたアクティブマトリクス表示装置。